



Физические основы электроники и радиоматериалы.э

- 1 По электропроводности все материалы делятся на ...
- 2 Основным видом проводимости в полупроводниках р-типа является ... проводимость
- 3 Наиболее распространенным полупроводниковым материалом является ...
- 4 С увеличением температуры проводимость собственного полупроводника ...
- 5 Изображенная на рисунке кристаллическая решетка называется ...
- 6 Процесс внедрения примесей в полупроводники называется ...
- 7 Основным видом проводимости в полупроводниках n-типа является ... проводимость
- 8 При взаимодействии электрона с дыркой происходит ... зарядов
- 9 На рисунке изображена зонная структура, характерная для ...
- 10 При прямом включении р-n-перехода высота потенциального барьера ...
- 11 Связи в кристаллической решетке полупроводника носят ... характер
- 12 Направленное движение свободных носителей заряда в полупроводниках под действием электрического поля – это ...
- 13 Когда на р-область перехода подается отрицательное напряжение, а на n-область – положительное, такое состояние р-n-перехода называется ...
- 14 При обратном включении р-n-перехода высота потенциального барьера ...
- 15 На рисунке изображена зонная структура, характерная для ...
- 16 Электрический ток в полупроводниках обеспечивается движением электронов, находящихся ...





- 17) Полупроводниковый диод ...
- 18) Когда на р-область перехода подается положительное напряжение, а на n-область – положительное той же величины, такое состояние р-n-перехода называется ...
- 19) Проникновение неосновных носителей заряда из р-области в n-область и обратно – это ...
- 20) Когда на р-область перехода подается положительное напряжение, а на n-область – отрицательное, такое состояние р-n-перехода называется ...
- 21) Оксид кремния является ...
- 22) ... – это вывод подключения диода, связанный с n-областью
- 23) Термоэлектронная эмиссия возникает при ...
- 24) При увеличении обратного напряжения емкость р-n-перехода ...
- 25) При увеличении концентрации примесей собственная проводимость полупроводника ...
- 26) При увеличении температуры в пределах рабочего диапазона примесная проводимость полупроводника ...
- 27) Ток в электровакуумном приборе может увеличиться в случае ...
- 28) При уменьшении прямого напряжения емкость р-n-перехода ...
- 29) ... – один из первых полупроводниковых материалов, получивших широкое практическое применение
- 30) Обратный ток р-n-перехода также называют ... током
- 31) Составляющими полного тока р-n-перехода являются ...
- 32) Электровакуумный прибор, называемый ..., содержит как минимум одну управляющую сетку
- 33) На рисунке изображен дефект кристаллической решетки, получивший название ...
- 34) Преодоление частицами потенциального барьера в случае, если ширина перехода меньше длины волны частицы, называется ... пробоем





- 35) Элементами электровакуумного триода являются ...
- 36) В полупроводниковом транзисторе в зависимости от его структуры ...
- 37) Эффект, возникающий в случае цепной ионизации атомов полупроводника вследствие соударения электронов с достаточной энергией, называется ...
- 38) На рисунке изображен дефект кристаллической решетки, получивший название ...
- 39) К полупроводниковым материалам относят ...
- 40) В р-п-переходе могут происходить ...
- 41) Эффект, возникающий вследствие саморазогрева полупроводника при протекании через р-п-переход обратного тока, называется ...
- 42) На рисунке изображен дефект кристаллической решетки, получивший название ...
- 43) При увеличении температуры в пределах рабочего диапазона обратный ток р-п-перехода ...
- 44) В порядке увеличения проводимости материалы располагаются следующим образом: ...
- 45) На рисунке изображен дефект кристаллической решетки, получивший название ...

